



La Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología
A través de la Facultad de Ciencias de la UASLP
Invita a Usted al Seminario:

Magneto-resistencia Anisotrópica Túnel (T-AMR) de un diodo Esaki $p + + -$
 $GaMnAs/n + -$

Que será impartido por: Dr. Edgar Briones (l'Université de Paris-Sud XI).

Resumen:

GaMnAs es un semiconductor ferromagnético diluido en el cual la interacción de canje es inducida por los portadores des-localizados. Debido a un fuerte acoplamiento spin-orbita la superficie de Fermi es bastante anisotrópica, así que, al elaborar una barrera túnel (filtro en el espacio-k) solo una parte de la densidad de estados de la superficie (L-DOS) contribuirá al transporte túnel. De manera interesante, la densidad local de estados puede modificarse mediante la rotación del vector de magnetización. La redistribución de L-DOS origina un cambio en la corriente túnel, denominado "Magneto-resistencia anisotrópica túnel" (T-AMR).

Este proyecto de investigación consiste en un estudio de las propiedades de magneto-transporte (T-AMR) de un diodo túnel Esaki GaMnAs/GaAs, las cuales están estrechamente relacionadas con la estructura de la banda de valencia del electrodo GaMnAs. Este dispositivo túnel permite realizar una espectroscopia de la T-AMR en el espacio de energía e impulsión, y de tal manera obtener una profunda comprensión del rol de la estructura de bandas de GaMnAs en la T-AMR. .

Lugar: Unidades de Posgrado, Sierra Leona #550, Lomas 2ª Sección, Cp 78210, Sala 2

Fecha: Miércoles 16 de Febrero de 2011

Hora: 13:00 hrs.